Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0309U007217

Державний реєстраційний номер: 0108U000590

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-04-2009

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технології модульних напівпровідникових гетероструктурних елементів

Початок етапу: 01.2008

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (03-244) 3-33-32, 3-81-11

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технологій одержання гетероструктур для тонкоплівкових сонячних батарей

Назва роботи англійською:

Development of technologies of receipt of heterostructure thin films solar battery

Реферат українською:

Досліджено вплив умови росту тонких плівок осаджених методом лазерної епітаксії. А саме, напівпровідники CdTe, CdSe та CdS на підкладках в основному ITO, а також на підкладках Al2O3, Si і GaAs. Отримано результати по повторювальності процесу осадження матеріалу. Обгрунтовані технологічні параметри. Проведено дослідження морфології поверхні, та зроблено рентгеноструктурний аналіз. Досліджено електричні властивості тонких плівок, які використовуються як матеріали для сонячних батарей. Виміряні вольт-амперні характеристики для структур CdTe/CdS/ITO, а також порівняно зі структурами CdTe/CdS/Si.

Реферат англійською:

Influencing of condition of growth of thin films of besieged is explored by the method of laser epitaxy. Namely, the CdTe, CdSe and CdS semiconductors on substrates mainly ITO, and also on substrates Al2O3, Si and GaAs. Results on sability are got process of besieging of material. The grounded technological parameters. Research of morphology of surface is conducted, and done X-ray analysis. Electric properties of thin films which are used as materials for sun batteries are explored. The measured volt-amper descriptions for the CdTe/CdS/ITO structures, and also comparatively with the CdTe/CdS/Si structures.

Індекс УДК: 535, 681.315.592

Коди тематичних рубрик: 29.31.01

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Вірт Ігор Степанович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/ HgCdTe// Физика и техника полупроводников- т. 42, вып 7, 2008 р., С. 788-792.
2.P.Potera, P. Sagan, I.Virt, M. Kuzma, G. Wish Struktural and optical properties of layers of pentacene formed by PLD method // Central European Journal of Physics.- V. 6, Iss. 4, 2008 p., P. 765-770.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Скотний Валерій Григовович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

